【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成23年8月4日(2011.8.4)

【公開番号】特開2006-201778(P2006-201778A)
【公開日】平成18年8月3日(2006.8.3)
【年通号数】公開・登録公報2006-030
【出願番号】特願2006-9643(P2006-9643)
【国際特許分類】
Ｇ０３Ｆ　7/039　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/027　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０３Ｆ　7/039　６０１
Ｈ０１Ｌ　21/30　５０２Ｒ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成23年6月16日(2011.6.16)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７９】
基体上のフォトレジストコーティングの現像に続いて、現像された基体は、例えば、レジストが除去された基体領域を、当該技術分野で公知の手順に従って化学的エッチング又はメッキすることによって、レジストが除去されたこれらの領域上において選択的な処理がなされ得る。マイクロ電子基体の製造、例えば、二酸化ケイ素ウェーハの製造のために、好適なエッチング剤には、ガスエッチング剤、例えばハロゲンプラズマエッチング剤、例えば、プラズマストリームとして適用されるCl_2又はCF_4／CHF_3エッチング剤をはじめとする塩素又はフッ素系エッチング剤が含まれる。かかる処理の後、公知の剥離手順を使用して、処理した基体からレジストが除去されてもよい。